

**ЛАЗЕРНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ
ФОТОЭФФЕКТ НА ПРИМЕСНЫХ ИОНАХ Nd³⁺ НА
ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА ZrO₂**

В.С.Летохов, С.К.Секацкий, С.Б.Мирох¹⁾

Институт спектроскопии АН СССР
142092, Троицк, Московская обл.

1) Институт общей физики АН СССР
117942, г. Москва

Поступила в редакцию 23 июля 1991 г.

Обсуждается возможность наблюдения лазерного ступенчатого резонансного фотоэффекта. Приведены данные о фотоэмиссии электронов с поверхности кристаллов ZrO₂ : Nd³⁺, которые интерпретированы как наблюдение данного эффекта.

В настоящее время хорошо известна и продолжает интенсивно изучаться лазерная резонансная ступенчатая фотоионизация свободных атомов и молекул¹. Представляет большой интерес попытаться наблюдать эффект резонансной ступенчатой фотоионизации для примесных частиц на поверхности.

Можно указать твердотельную систему, для которой существует набор изолированных энергетических уровней между основным состоянием системы и ее границей ионизации. Это - находящиеся в кристаллической диэлектрической матрице ионы переходных металлов с достраивающейся *d*-или *f*-оболочкой. В таком кристалле возникает набор энергетических уровней, принадлежащих *d*ⁿ или *f*ⁿ конфигурации иона переходного металла. Последовательное ступенчатое резонансное лазерное возбуждение редкоземельных ионов в матрицах неоднократно наблюдалось (см., например, ² и ссылки там). Авторами была поставлена задача поиска и изучения ступенчатого резонансного лазерного фотоэффекта в таких средах. Идея эксперимента иллюстрируется на рис. 1. Лазерное излучение различными способами может перевести находящийся в матрице ион в высоколежащее состояние, с которого возможен перенос энергии на матрицу с образованием электрона выше уровня вакуума и последующим выходом его из диэлектрика (фотоэффект).

Исследуемые образцы прижимались к металлическому электроду и под углом примерно 45° облучались наносекундными лазерными импульсами, сфокусированными в пятно площадью $7 \cdot 10^{-3}$ см². На электрод с образцом подавалось постоянное напряжение от -2,5 до +2,5 кВ, которое направляло фотоэлектроны (фотоионы) на вторичный электронный умножитель ВЭУ-6 с заземленным входом. Исследования проводились в вакуумной камере, откачиваемой обычным диффузионным насосом через азотную ловушку (вакуум порядка 10⁻⁵ торр). Некоторые контрольные эксперименты были проведены в условиях безмасляного вакуума того же порядка 10⁻⁵ торр; заметных отличий в величине электронного и ионного сигналов не обнаружено. Для измерений брались только сколотые образцы, предварительно промываемые в спирте и ацетоне.

Отметим, что ранее неоднократно наблюдалась фотоэмиссия из диэлектрических кристаллов под действием лазерного излучения мощностью $10^3 < P < 10^9$ Вт/см², которая объясняется многофотонным нерезонансным

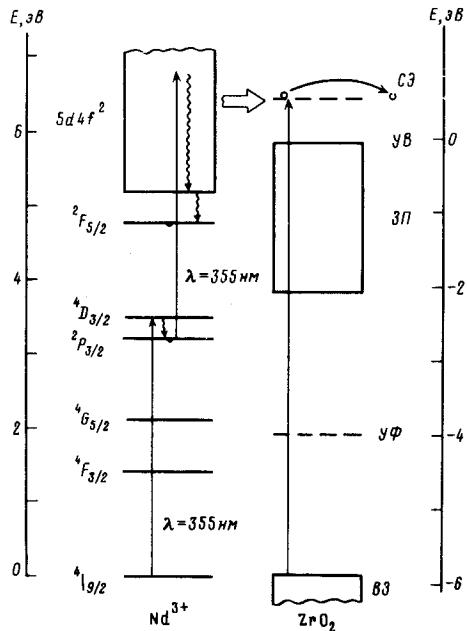


Рис. 1. Схема, поясняющая процесс лазерного ступенчатого резонансного фотоэффекта. Слева указаны некоторые уровни энергии иона Nd^{3+} в матрице, за нуль энергии принята энергия основного состояния. Справа - упрощенная зонная структура матрицы. ВЗ - валентная зона, ЗП - зона проводимости, УФ - уровень Ферми, СЭ - свободный электрон, УВ - уровень вакуума. Процесс передачи возбуждения указан широкой стрелкой

фотоэффектом либо эффектами, связанными с поглощающими неоднородностями малого размера^{3,4}. Для всех исследованных образцов и длин волнами также была зарегистрирована нерезонансная фотоэмиссия электронов и ионов, соответствующий экспериментальный материал будет опубликован позже.

На рис. 2 приведена зависимость выхода фотоэлектронов $N_{\text{ФЭ}}$ от энергии лазерных импульсов $E_{\text{лаз}}$ для третьей гармоники лазера на неодимовом стекле (полуширина импульса $T_{1/2} = 15$ нс, длина волны 355 нм). Для активированного образца $\text{ZrO}_2 : \text{Nd}^{3+}$ (концентрация ионов Nd составляла 0,3 ат.%, кристалл ZrO_2 был стабилизирован 16% окисью Gd) наблюдается снижение более чем на порядок порога появления квадратичной зависимости выхода фотоэффекта по сравнению с аналогичным порогом обычного нерезонансного двухфотонного фотоэффекта (кривые 2 - 4) во всех исследованных образцах, в том числе и в неактивированных кристаллах. Такое различие в порогах не наблюдается при облучении образцов наносекундными импульсами второй гармоники лазера на неодимовом стекле (532 нм) и азотного лазера (337 нм). Это мы связываем с наличием двухступенчатого резонансного фотоэффекта в кристалле $\text{ZrO}_2 : \text{Nd}^{3+}$ при облучении его на длине волны 355 нм. Приведем соответствующие оценки.

Излучение с длиной волны 355 нм лежит в области прозрачности кристалла ZrO_2 ⁵ и вызывает следующую последовательность переходов иона Nd^{3+} (см. рис. 1): $^4I_{9/2} \rightarrow ^4D_{3/2}$ (сечение порядка 10^{-19} см^2), затем быстрая субнаносекундная безызлучательная релаксация $^4D_{3/2} \sim ^2P_{3/2}$ ^{6,7} и переход $^2P_{3/2}$ - уровень $5d4f^2$ конфигурации. Уровни $5d4f^2$ конфигурации иона Nd^{3+} занимают в кислородных кристаллах очень широкий энергетический диапазон в несколько тысяч cm^{-1} , и нет оснований полагать, что отличие положений уровней d -конфигурации в матрицах YAG и ZrO_2 столь велико, что способно вывести указанный $f-d$ -переход из резонанса (данные об уровнях d -конфигурации в YAG см. в⁸).

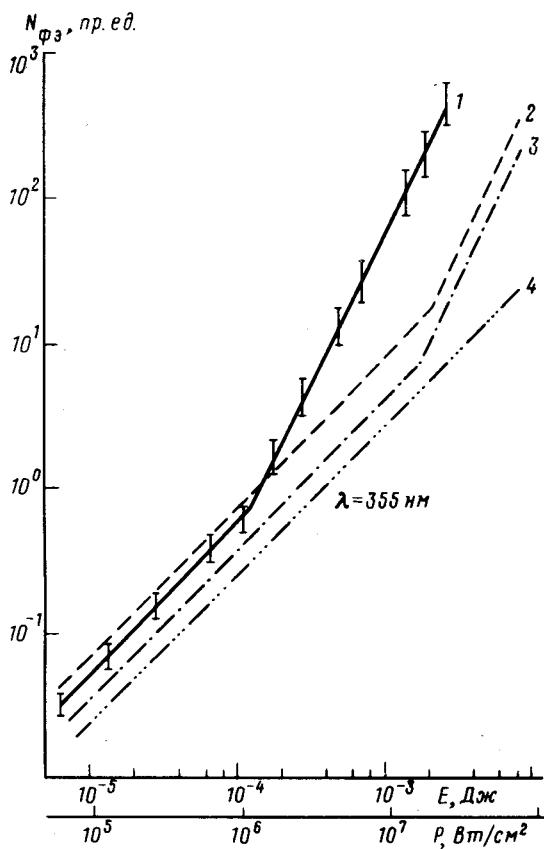


Рис. 2. Зависимость выхода фотоэлектронов от энергии лазерного импульса, 1 - резонансный двухступенчатый фотоэффект в $ZrO_2 : Nd^{3+}$, 2 - нерезонансный двухфотонный фотоэффект в ZrO_2 , 3 - то же в $YAG : Nd^{3+}$, 4 - нерезонансный однофотонный фотоэффект в стекле ЛК5

Все интересующие нас спектроскопические параметры иона Nd^{3+} измерены в ⁷ для матриц YAG, YGaG и (частично) стекла ED-2. Именно, время жизни метастабильного уровня $^2P_{3/2}$ составляет $T_{1/2} = 0,3 - 0,4$ мкс, сечение дипольно-разрешенного $f - d$ -перехода $\sigma \simeq 10^{-17} \div 10^{-16}$ см²; возбужденный уровень d -конфигурации через 2 - 5 нс релаксирует на долгоживущий метастабильный уровень $^2F_{5/2}$ ($T_{1/2} \simeq 2 \div 3$ мкс), обладающий энергией $E \simeq 37500$ см⁻¹. Можно ожидать, что и для матрицы ZrO_2 указанные параметры имеют тот же порядок величины.

Оценим количество возбужденных ионов Nd^{3+} , которые могли бы внести вклад в процесс ступенчатого фотоэффекта. Глубина выхода фотоэлектронов для большинства диэлектрических материалов составляет 1 - 10 нм ⁹, т.е. в "активной зоне" кристалла находится примерно 10^{11} ионов неодима. Действующее на переходе сечением σ лазерное излучение плотностью энергии E возбуждает лишь некоторую часть от всех облученных ионов, η , которую можно найти по формуле: $\eta = E\sigma/\hbar\omega$, где $\hbar\omega$ - энергия кванта. В нашем случае для импульса энергий 1 мДж мы приходим к величине $\eta_1 \simeq 2,5 \cdot 10^{-2}$ в случае перехода $^4I_{9/2} - ^4D_{3/2}$ и $\eta_2 \simeq 1$ для $f - d$ -перехода. То есть до $2,5 \cdot 10^9$ ионов в "активной" зоне может быть возбуждено в уровне d -конфигурации. Предположив, что основная часть наблюдаемых фотоэлектронов обусловлена многоступенчатым фотоэффектом, мы получим, что $10^{-5} - 10^{-6}$ часть от всех возбужденных в d -конфигурацию ионов рождает фотоэлектрон после передачи возбуждения в матрицу. Процесс передачи возбуждения в матрицу "целиком", без размена на многие фононы, ранее наблюдался (флюoresценция матрицы YVO_4 после

двухступенчатого возбуждения иона Nd³⁺ на $\lambda = 532$ нм ^{7).}

Исходя из данных о работе выхода и ширине запрещенной зоны кристаллов ZrO₂^{10,11} следует ожидать, что генерация фотоэлектронов возможна в результате передачи матрице возбуждения с энергией больше 5 - 6 эВ. В нашем случае в результате двухступенчатого поглощения ион Nd³⁺ приобретает энергию до 6,6 эВ, т.е. заведомо большую порога фотоэффекта. Возможно, что существенную роль играют также и поглощение лазерного излучения с уровней d-конфигурации или метастабильного уровня ²F_{5/2} иона Nd³⁺.

Таким образом, нам удалось найти образец (ZrO₂ : Nd³⁺) и условия лазерного облучения (наносекундные импульсы с $\lambda = 355$ нм), при которых характер эмиссии фотоэлектронов заметно отличается от остальных исследованных случаев. Данное отличие, на наш взгляд, может быть интерпретировано как лазерный резонансный ступенчатый фотоэффект.

Авторы благодарят А.А.Ораевского и Р.О.Есеналиева за предоставленную им возможность использовать для экспериментов лазер на неодимовом стекле и Е.Е.Ломонову за любезное предоставление образцов ZrO₂.

-
1. Летохов В.С. Лазерная фотоионизация спектроскопия. М.: Наука, 1987.
 2. Каминский А.А., Антиленко Б.М. Многоуровневые функциональные схемы кристаллических лазеров. М.: Наука, 1989.
 3. Barashev P.P. Phys. Stat. Solidi A, 1972, **9**, 9.
 4. Лазнева Л.Ф. Лазерная десорбция. Л.: ЛГУ, 1990.
 5. Александров В.И., Воронько Ю.К., Михалевич В.Г. и др. ДАН, 1971, **199**, 1282.
 6. Weber M.J. Phys. Rev. B, 1973, **8**, 54.
 7. Quarles G.J., Venikouas G.E., Powell R.C. Phys. Rev. B., 1985, **31**, 6935.
 8. Горбань И.С., Гуменюк А.Ф., Дегода В.Я. Опт. и спектр., 1985, **58**, 464.
 9. Howle W.A., Engel W., Willig F. et al. Ultramicroscopy, 1982, **7**, 371.
 10. Физико-химические свойства оксидов. Справочник под ред. Г.В.Самсонова. М.: Металлургия, 1978, с. 223.
 11. Фоменко В.С., Подчерняева И.А. Эмиссионные и адсорбционные свойства веществ и материалов. Справочник. М.: Атомиздат, 1975, с. 150.